真空中でレーザー照射により得られた 1T-MoTe<sub>2</sub> と 2H-MoTe<sub>2</sub> のコンタクト特性の評価

Study of the contact property between 2H-MoTe<sub>2</sub> and 1T-MoTe<sub>2</sub> induced by laser irradiation in vacuum

千葉大物質 <sup>1</sup> 埼玉大物質 <sup>2</sup> 謝天順 <sup>1</sup>, 池田駿太郎 <sup>1</sup>, 坂梨昂平 <sup>1</sup>, 上野啓司 <sup>2</sup>, 青木伸之 <sup>1</sup> Chiba Univ. <sup>1</sup>, Saitama Univ. Tianshun Xie <sup>1</sup>, Shuntaro Ikeda <sup>1</sup>, Kohei Sakanashi <sup>1</sup>, Keiji Ueno <sup>2</sup>, and Nobuyuki Aoki <sup>1</sup> E-mail: n-aoki@faculty.chiba-u.jp

遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)は遷移金属とカルコゲン原子の組み合わせに より金属、半導体、超伝導と幅広い物性を示すことからデバイスへの応用研究が盛んに行 われている。TMDC の主な結晶構造としては、半導体的な性質を示す 2H型、半金属的 な性質を示す 1T 型および 1T'型がある。 ニテルル化モリブデン (MoTe2) はバルクでは約 0.9 eV のバンドギャップを有する間接遷移半導体、単層では 1.0 eV のバンドギャップを 持つ直接遷移半導体として知られている。2015年、Cho らによって MoTe<sub>2</sub> にレーザー照 射を行うことによって結晶構造を変化させ、物性が半導体から金属へとシフトすることが 報告された。また、MoTe2トランジスタに用いる金属材料にレーザー照射相を用いること での Schottky 抵抗の低減なども報告されている[1]。これまで、レーザー照射による結晶 相変化はすべて大気中で行われており、我々は大気中でのレーザー照射により得られる部 分は、1T'相ではなく Te 相であることを明らかにした [2]。本研究は、2H-MoTe₂に真空中 でレーザー照射を行い、照射された部分をラマン分光法で解析したところ、元の 2H 相の  $E_{2g}$  ピーク(232 cm<sup>-1</sup>)と  $A_{1g}$  ピーク(171 cm<sup>-1</sup>)が消失し、1T 相のラマンピークと一致す る 155 cm<sup>-1</sup>、245 cm<sup>-1</sup>の新しいピークが発生していることがわかった。 したがって、 2H-MoTe<sub>2</sub>に真空中でレーザーを照射すると、結晶が 2H(半導体相)から 1T(半金属相) に変化すると考える。 この結果を踏まえて 1T-MoTe<sub>2</sub>と 2H-MoTe<sub>2</sub>の接触特性を調べた。 真空中で、2H-MoTe2結晶の両側にレーザーを照射して、1T-2H-1Tの in-plane 接合という 構造を得て、1T-MoTe2の上と真ん中の2H-MoTe2の上に金属電極(Cr/Au)を作製するこ とで、図1に示すような FET 構造を作製した。真空環境下において、異なる温度でのゲ ート電圧特性を測定した結果、1T-MoTe2コンタクトは図2に示すようにn型に支配され る両極性特性が確認された。高温から低温までの温度特性から得られた障壁の高さについ て議論する。また、中央の 2H 部分については、Cr/Au コンタクトによる FET 特性も測定 しており、コンタクト特性の違いについても議論する。

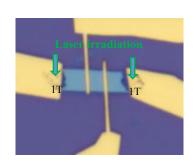


Fig. 1. Optical microscope image of the FET sample.

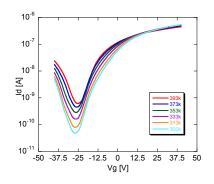


Fig. 2 Gate voltage dependences of the FET sample at different temperatures.

- [1] S. Cho et al., Science. 349, 625-628 (2015).
- [2] K. Sakanashi et al., Nanotechnology 31, 205205 (2020).